

Перечень победителей конкурса на получение грантов Российского научного фонда по мероприятиям: «Проведение ориентированных научных исследований в рамках стратегических инициатив Президента Российской Федерации в научно – технологической сфере» и «Проведение прикладных научных исследований в рамках стратегических инициатив Президента Российской Федерации в научно – технологической сфере» по направлению «Микроэлектроника» стратегических инициатив Президента Российской Федерации в научно – технологической сфере

П/П	Лот	Номер заявки на проект	Организация-победитель	Тема проекта
1	Лот №1	23-91-01001	ИПМаш РАН,	Разработка специальных подложек кубического карбида кремния на кремнии (3C-SiC/Si) для роста транзисторных гетероструктур Ga(Al)N с высокой подвижностью носителей заряда (HEMT)
2	Лот №2	23-91-01006	МИЭТ	Исследование и моделирование конструкции транзисторных наногетероструктур типа AlGaN/GaN на подложках кремния и специальных подложках кубического карбида кремния на кремнии (3C-SiC/Si)
3	Лот №3	23-91-01013	АО «Дизайн Центр «Союз»	Исследование и разработка аналого-цифровой СБИС в специализированном корпусе для МЭМС-микрофона
4	Лот №4	23-91-01009	ФТИ им. А.Ф. Иоффе	Разработка технологии МОС-гидридной эпитаксии полупроводниковых гетероструктур лазерных источников для гетерогенной интеграции Si/A3B5
5	Лот №5	23-91-01012	ФИЦ ИУ РАН	Разработка программных средств системы автоматизированного проектирования ЭКБ для создания ячеек энергонезависимой памяти на основе технологий ReRAM, FeRAM, MRAM, шифр «CoBa»
6	Лот № 6	23-91-01003	АО «Светлана-Рост»	Доработка критических элементов технологии в целях организации серийного производства бескорпусных GaAs СВЧ МИС с проектной нормой до 0,25 мкм для радиоаппаратуры систем навигации, телекоммуникации и радиолокации диапазона частот до 40ГГц»
7	Лот № 8	23-91-01015	ФИЦ ПХФ и МХ РАН	Разработка ПАВ для безметального проявителя для производства интегральных схем

8	Лот № 9	23-91-01005	АО «Светлана-Рост»	Разработка библиотеки топологий и моделей стандартных элементов и их апробация с целью создания методологии согласования импедансов мощных бескорпусных AlGaN СВЧ-транзисторов с проектной нормой до 0,5 мкм при проектировании аппаратуры систем навигации, телекоммуникации и радиолокации L-, S- и C-диапазонов
9	Лот № 10	23-91-01007	ИФП СО РАН	Разработка технологического процесса формирования эпитаксиальных слоев германия для рpn диодов (фотодетекторов) на длину волны 1,31 мкм, сопряженных с кремниевой волноводной структурой
10	Лот № 12	23-91-01014	АО «ЗНТЦ»	Разработка технологического процесса флип-чип монтажа кристаллов с алюминиевой металлизацией на интерпозер, подложку, корпус